

沼津工業高等専門学校		開講年度	令和06年度 (2024年度)		授業科目	電子デバイス		
科目基礎情報								
科目番号	2024-783			科目区分	専門 / 選択			
授業形態	授業			単位の種別と単位数	学修単位: 2			
開設学科	医療福祉機器開発工学コース			対象学年	専2			
開設期	前期			週時間数	2			
教科書/教材	古川静二郎, 荻野陽一郎, 浅野種正共著, 「電子デバイス工学」[第2版], 森北出版							
担当教員	大津 孝佳							
到達目標								
1. 半導体におけるバンドギャップの概念とキャリアの挙動, pn接合について, 基本特性をについて解析できる. 2. バイポーラトランジスタとMIS FET, それらを用いた回路について, 動作原理と基本特性を解析できる. 3. 修得した専門知識を, 環境エネルギー工学, 新機能材料工学, 医療福祉機器開発工学などの複合・融合領域の課題に応用できる. (C1-4)								
ルーブリック								
		理想的な到達レベルの目安		標準的な到達レベルの目安		未到達レベルの目安		
1. 半導体におけるバンドギャップの概念とキャリアの挙動, pn接合について, 基本特性をについて解析できる.		□半導体におけるバンドギャップの概念とキャリアの挙動, p n接合についてわかりやすく正確に解析できる.		□半導体におけるバンドギャップの概念とキャリアの挙動, p n接合について解析できる.		□半導体におけるバンドギャップの概念とキャリアの挙動, p n接合について解析できない.		
2. バイポーラトランジスタとMIS FET, それらを用いた回路について, 動作原理と基本特性を解析できる.		□バイポーラトランジスタとMIS FET, それらを用いた回路について, 動作原理と基本特性を正確に説明できる		□バイポーラトランジスタとMIS FET, それらを用いた回路について, 動作原理と基本特性を解析できる		□バイポーラトランジスタとMIS FET, それらを用いた回路について, 動作原理と基本特性を解析できない.		
3. 修得した専門知識を医療福祉機器開発工学などの複合・融合領域の課題に応用できる. (C1-4)		□修得した専門知識を医療福祉機器開発工学などの複合・融合領域の課題に例を挙げて詳細に応用できる.		□修得した専門知識を医療福祉機器開発工学などの複合・融合領域の課題に応用できる.		□修得した専門知識を医療福祉機器開発工学などの複合・融合領域の課題に応用できない.		
学科の到達目標項目との関係								
実践指針 (C1) 実践指針のレベル (C1-4) 【プログラム学習・教育目標】 C								
教育方法等								
概要	エレクトロニクスの根幹をなす電子デバイスについて, 半導体デバイスに主眼を置き, その物理的な原理やデバイスの構造と特性について学修する. 半導体の物理, pn接合, バイポーラトランジスタ, 電界効果トランジスタといった基本的な内容と, 光デバイスやパワーデバイスをとりあげる. この科目は企業で半導体レーザの開発を担当していた教員が, その経験を活かし, 半導体の基礎, 特性, 各種デバイス等について講義形式で授業を行うものである.							
授業の進め方・方法	教科書に沿って講義する. 関係する資料を配布やし関連する部品などを回覧する. 1 0 0 点満点の試験を1回実施し, その1結果を評価点とする.							
注意点								
授業の属性・履修上の区分								
□ アクティブラーニング		□ ICT 利用		□ 遠隔授業対応		□ 実務経験のある教員による授業		
授業計画								
前期	1stQ	週	授業内容			週ごとの到達目標		
		1週	授業概要と, 目標, 計画, 評価基準の説明			授業概要を理解できる.		
		2週	電子と結晶			価電子と結晶. 結晶と結合形式. 結晶の単位胞と方位について説明できる.		
		3週	エネルギーバンド			電子と結晶, エネルギー準位, エネルギーバンドの形成について説明できる.		
		4週	半導体のキャリア			真性半導体と外因性半導体のキャリア, n型とp型半導体キャリアについて計算できる.		
		5週	フェルミ準位			キャリア密度とフェルミ準位, 多数キャリアと少数キャリアについて計算できる.		
		6週	半導体の電気伝導			ドリフト電流と拡散電流, キャリア連続の式について計算できる.		
		7週	pn接合			pn接合とダイオードの動作原理, 電圧-電流特性, 実際の構造について説明できる.		
	2ndQ	8週	ダイオード			空乏層について説明でき, 接合容量を計算できる.		
		9週	バイポーラトランジスタ			バイポーラトランジスタの動作原理, 電流増幅率について説明できる.		
		10週	金属-半導体接触			ショットキーバリアとオーミック接触を説明できる.		
		11週	MESFET			MESFETの構造と動作原理について説明できる.		
		12週	MISFET			MISFETの動作原理と特性, MOSFETの実際について説明できる.		
		13週	集積回路			IC構造の構成と実際, MOS論理回路, RAMとROM, フラッシュメモリについて説明できる.		
		14週	光半導体デバイス			光電効果, ホトダイオードと太陽電池, 発光デバイスについて説明できる.		
		15週	パワーデバイス			パワーデバイスについて説明できる.		
16週								
モデルコアカリキュラムの学習内容と到達目標								
分類	分野	学習内容	学習内容の到達目標			到達レベル	授業週	
評価割合								

	試験	発表	相互評価	態度	ポートフォリオ	その他	合計
総合評価割合	100	0	0	0	0	0	100
1. 半導体におけるバンドギャップの概念とキャリアの挙動, pn接合について, 基本特性をについて解析できる.	40	0	0	0	0	0	40
2. バイポーラトランジスタとMIS FET, それらを用いた回路について, 動作原理と基本特性を解析できる.	40	0	0	0	0	0	40
3. 修得した専門知識を医療福祉機器開発工学などの複合・融合領域の課題に応用できる. (C1-4)	20	0	0	0	0	0	20